

Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0 - SSD - verschlüsselt - 4 TB - intern - M.2 2280 - PCIe 5.0 x2 (NVMe)

256-Bit-AES - TCG Opal Encryption 2.0

Gruppe	SSDs
Hersteller	Samsung
Hersteller Art. Nr.	MZ-V9S4T0BW
EAN/UPC	8806095575667



Beschreibung

Die Samsung 990 EVO Plus ist ein leistungsstarkes internes Solid State-Laufwerk, das mit einer Kapazität von 2 TB die Speicherleistung erhöht. Ausgestattet mit der Samsung V-NAND TLC-Technologie gewährleistet dieses Laufwerk eine Hochgeschwindigkeitsdatenübertragung mit einer internen Datenrate von 7250 MB/s und einer Schreibgeschwindigkeit von 6300 MB/s, was einen nahtlosen Betrieb für anspruchsvolle Anwendungen und die Verwaltung großer Dateien ermöglicht. Mit der Unterstützung von PCI Express 4.0- und 5.0-Schnittstellen erfüllt es verschiedene Systemanforderungen und bietet gleichzeitig Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit.

Mit fortschrittlichen Funktionen wie der Intelligent TurboWrite Technology und einem Auto Garbage Collection Algorithmus sorgt die Samsung 990 EVO Plus auch bei hoher Arbeitsbelastung für Effizienz und Haltbarkeit. Mit einer Stoß- und Vibrationsfestigkeit von bis zu 1500 g und einem Temperaturbereich von -40°C bis 85°C ist sie sowohl für private als auch für professionelle Umgebungen geeignet. Diese SSD gewährleistet einen schnellen Datenzugriff und bietet eine Hardwareverschlüsselung für verbesserte Sicherheit, was sie zu einer idealen Wahl für Benutzer macht, die die Systemleistung verbessern möchten.

Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Samsung 990 EVO Plus MZ-V9S2T0 - SSD - 4 TB - PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Typ	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	22.15 mm x 80.15 mm x 2.38 mm
Gewicht	9 g

Ausführliche Details

Allgemein

Gerätetyp	Solid State Drive - intern
Kapazität	4 TB
Hardwareverschlüsselung	Ja
Verschlüsselungsalgorithmus	256-Bit-AES
NAND-Flash-Speichertyp	TLC (Triple-Level Cell)
Formfaktor	M.2 2280
Schnittstelle	PCIe 5.0 x2 (NVMe)
Merkmale	Intelligent TurboWrite Technology, Samsung V-NAND TLC Technology, Geräte-Schlafunterstützung, Host Memory Buffer (HMB), TRIM-Unterstützung, Auto Garbage Collection Algorithm, S.M.A.R.T., IEEE 1667
Breite	22.15 mm
Tiefe	80.15 mm
Höhe	2.38 mm
Gewicht	9 g
Leistung	
Interner Datendurchsatz	7250 MBps (lesen)/ 6300 MBps (Schreiben)
Maximal 4 KB Random Write	1400000 IOPS
Maximal 4 KB Random Read	1050000 IOPS
Zuverlässigkeit	
MTBF	1.500.000 Stunden
Erweiterung und Konnektivität	
Kompatibles Schaltfeld	M.2 2280
Stromversorgung	
Energieverbrauch	5.5 Watt (Lesen) 4.8 Watt (Schreiben) 60 mW (Standby) 5 mW (Sleep-Modus)
Software & Systemanforderungen	
Software inbegriffen	Samsung Magician Software
Verschiedenes	
Gehäusematerial	Nickelbeschichtung
Abmessungen & Gewicht (Transport)	
Transportbreite	9.9 cm
Transporttiefe	2.29 cm
Transporthöhe	14.2 cm
Herstellergarantie	
Service und Support	Begrenzte Garantie - 5 Jahre / 2400 TBW
Umgebungsbedingungen	
Min Betriebstemperatur	0 °C
Max. Betriebstemperatur	70 °C

Min. Lagertemperatur	-40 °C
Max. Lagertemperatur	85 °C
Zulässige Luftfeuchtigkeit im Betrieb	5 - 95 % (nicht kondensierend)
Schocktoleranz (nicht in Betrieb)	1500 g @ 0,5 ms
Vibrationstoleranz (nicht in Betrieb)	20 g @ 20-2000 Hz

Technische Daten © 1WorldSync. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.